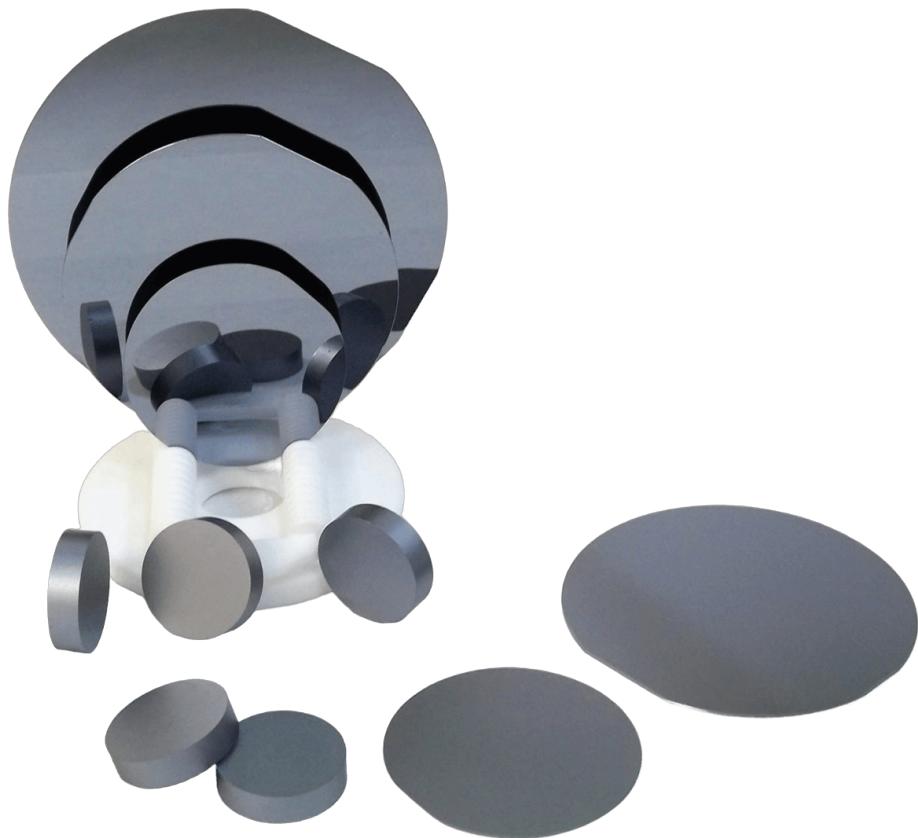


## Арсенид Галлия (GaAs)

**Производитель:**

АО «Диполь Технологии»

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

GaAs - это полупроводниковый материал с превосходными эксплуатационными характеристиками, включая большую ширину запрещенную зону, высокую подвижность электронов и высокую эффективность преобразования.

Арсенид галлия часто используется в качестве материала подложки для эпитаксиального выращивания других полупроводников III-V типа, включая арсенид индия-галлия, арсенид алюминия-галлия и других.

### Применение

Арсенид галлия применяется для изготовления полевых транзисторов с эффектом Шоттки (ПТШ), фотоэлементов, полупроводниковых лазеров с длиной волны излучения 0,83-0,92 мкм, интегральных микросхем повышенного быстродействия и степени интеграции на полевых транзисторах с эффектом Шоттки, фотокатодов с малой работой выхода электронов, туннельных диодов, диодов Ганна.

## Спецификация

GaAs		
Тип проводимости / легирующая примесь	S-I	P / Zn
Применение	микроэлектроника	
Метод выращивания		
Диаметр (мм)		
Ориентация		
Толщина (мкм)		
Концентрация носителей	—	(0.5-5)
Удельное сопротивление ( $\Omega \cdot \text{см}$ )	$>10^7$	(1.2-9.9)
Мобильность ( $\text{см}^2/\text{В}\cdot\text{сек}$ )	$>4000$	50-100
EPD ( $1/\text{см}^2$ )	$<5000$	$<50$

Подложки GaAs с другими параметрами также доступны по запросу.  
Производство: Китай, Малайзия, Турция. Также доступны эпитаксиальные структуры на основе GaAs.